







	<p><b>SIRA06DP-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIRA06DP-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.SIRA06DP-T1-GE3.pdf</a> <a href="#">2.SIRA06DP-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 82862 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA06DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	82862 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3595pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIRA06DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA06DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA06DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA06DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIRA10BDP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p><b>SIRA10DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA02DP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 50A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA04DP</b> VISHAY VISHAY DFN56</p>
 <p><b>SIRA06DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA10DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SIRA06DP</b> VISHAY VISHAY DFN56</p>	 <p><b>SIRA04DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

SIRA06DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIRA06DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIRA06DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA06DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA06DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIRA06DP-T1-GE3
SIRA06DP-T1-GE3 Electronic	SIRA06DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA06DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA06DP-T1-GE3-Bild	SIRA06DP-T1-GE3-Teil
SIRA06DP-T1-GE3 Preis	SIRA06DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA06DP-T1-GE3 Bild	SIRA06DP-T1-GE3 Aktie	SIRA06DP-T1-GE3 Inventar
SIRA06DP-T1-GE3 Neu	SIRA06DP-T1-GE3 Original	SIRA06DP-T1-GE3 garantiert	SIRA06DP-T1-GE3 RFQ	SIRA06DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited